

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/FR05/000168

International filing date: 26 January 2005 (26.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: FR
Number: 0400907
Filing date: 30 January 2004 (30.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 01 April 2005 (01.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

- 2 FEV. 2005



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 24 JAN. 2005

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr





26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DE 540 - R / 210502

REMISE DES PIÈCES DATE 30 JAN 2004 LIEU 75 INPI PARIS 34 SP N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 30 JAN. 2004 PAR L'INPI		Réservé à l'INPI 0400907		<input checked="" type="checkbox"/> NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE " CABINET NETTER 36 avenue Hoche 75008 PARIS "	
Vos références pour ce dossier (facultatif) SOPRA 20 (121001)					
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
<input checked="" type="checkbox"/> NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes			
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>			
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>			
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>			
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d'utilité initiale		N°		Date	
		N°		Date	
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>		Date	
Demande de brevet initiale		N°		Date	
<input checked="" type="checkbox"/> TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Masque à motifs protégés, pour la lithographie par réflexion dans le domaine de l'extrême UV et des rayons X mous					
<input checked="" type="checkbox"/> DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			
<input checked="" type="checkbox"/> DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique			
Nom ou dénomination sociale		SOCIETE DE PRODUCTION ET DE RECHERCHES APPLIQUEES - SOPRA			
Prénoms					
Forme juridique		Société anonyme			
N° SIREN		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Code APE-NAF		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Domicile ou siège	Rue	26 rue Pierre Joigneaux			
	Code postal et ville	92270 BOIS COLOMBES			
	Pays	FRANCE			
Nationalité		française			
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)					
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»					

Remplir impérativement la 2^{ème} page



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES
DATE 75 INPI PARIS 34 SP
LIEU
N° D'ENREGISTREMENT
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DB 540 W / 210502

6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)		
Nom	PLAÇAIS	
Prénom	Jean-Yves	
Cabinet ou Société	Cabinet NETTER	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		
Adresse	Rue	36 avenue Hoche
	Code postal et ville	75 010 PARIS
	Pays	France
N° de téléphone (facultatif)	01 58 36 44 22	
N° de télécopie (facultatif)	01 42 25 00 45	
Adresse électronique (facultatif)		
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)
Établissement immédiat ou établissement différé	<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Paris, le 30 janvier 2004 Jean-Yves PLAÇAIS 92-1197 (B)(M)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI

**MASQUE À MOTIFS PROTÉGÉS, POUR LA LITHOGRAPHIE PAR RÉFLEXION
DANS LE DOMAINE DE L'EXTRÊME UV ET DES RAYONS X MOUS**

5

L'invention concerne le domaine des masques à motifs utilisés en lithographie optique.

10 La lithographie optique est une technique bien connue permettant de reproduire sur une couche de résine, déposée sur un substrat (ou "wafer"), des motifs présents sur l'une des faces d'un masque à l'aide d'un faisceau de photons et d'un dispositif optique de projection, le plus souvent par réduction.

15 Comme le sait l'homme de l'art, la résolution des traits des motifs, formés (ou "insolés") dans la résine, est proportionnelle à une dimension critique CD égale à $k\lambda/NA$, où λ est la longueur d'onde des photons du faisceau, k est un coefficient inférieur à 1 représentant l'effet des artifices utilisés pour abaisser les limites théoriques (comme par exemple la non-linéarité de la résine), et NA est l'ouverture numérique du faisceau de photons au niveau des motifs. En d'autres termes, les dimensions des motifs reproduits dépendent de la longueur
20 d'onde des photons utilisés.

En raison des propriétés et avantages offerts par les composants électroniques de très petites dimensions, on utilise, pour les réaliser, des longueurs d'onde toujours plus petites. Ainsi, on est progressivement passé de photons présentant une longueur d'onde dans le visible (436
25 nm) à des photons présentant une longueur d'onde dans l'ultraviolet (UV) proche (365 nm ou 248 nm), puis à des photons présentant une longueur d'onde dans l'ultraviolet lointain (193 nm ou 157 nm), en utilisant respectivement les raies G et I du mercure, puis des lasers à excimères KrF, ArF et F₂.

30 Les masques étant difficiles à fabriquer sans défaut, et particulièrement onéreux, ils doivent donc être protégés afin de ne pas être "perturbés" par des particules ambiantes. Une telle protection est relativement simple à mettre en oeuvre lorsque le masque est transparent aux photons utilisés pour la reproduction de ses motifs. Dans ce cas, le masque peut en effet être

utilisé en transmission, si bien qu'il est possible de placer une membrane protectrice fine et en matériau transparent et non perturbant, par exemple en polymère, devant sa face avant (où se trouvent placés les motifs à reproduire), afin que les particules "perturbatrices" (ou indésirables) soient retenues à une distance des motifs interdisant leur reproduction sur la
5 résine (typiquement 6 mm). Cette membrane protectrice (ou pellicule) peut être nettoyée, et dans certains cas elle peut être remplacée après inspection.

Lorsque l'on tend vers les limites de transparence du masque, par exemple pour une longueur d'onde de 157 nm, la protection de ses motifs est plus délicate. Il faut d'abord purger le trajet
10 optique avec de l'Azote (N_2) pour enlever les gaz, tels que l'oxygène (O_2), les molécules, telles que l'eau (H_2O), et les polymères absorbants. Puis, il faut placer devant les motifs une pellicule protectrice solide, en quartz spécial SiOF ou en CaF_2 , transparente à 157 nm, traitée antireflet, présentant des faces très parallèles et une épaisseur choisie de sorte qu'elle fasse partie du calcul optique de formation de l'image des motifs sur la résine.

15 Lorsque la longueur d'onde des photons est dans le domaine de l'ultraviolet (UV) extrême, voire même des rayons X mous (typiquement entre environ 120 nm et environ 1 nm), le masque n'est plus transparent, si bien qu'il doit être utilisé en réflexion. Un tel masque est alors constitué d'un substrat planaire solidarisé à une structure réfléchissante à la longueur
20 d'onde des photons utilisés (réalisée, par exemple pour une longueur d'onde de 13,5 nm (située dans l'ultra violet extrême), sous la forme d'une structure multicouches constituée d'une alternance de couches de Silicium (Si) et de Molybdène (Mo)) et comportant une face avant munie de motifs choisis, réalisés dans un matériau absorbant à ladite longueur d'onde (par exemple en Cr ou en TaN).

25 Or, pour ce type de masque utilisé en lithographie par réflexion, il n'existe pas de moyen connu permettant de protéger les motifs.

L'invention a donc pour but de remédier à cet inconvénient.

30 Elle propose à cet effet un masque à motifs, pour un dispositif de lithographie par réflexion d'un faisceau de photons de longueur d'onde (λ) inférieure à environ 120 nm (et d'ouverture numérique (NA) choisie au niveau des motifs), comprenant un substrat planaire solidarisé à

une structure réfléchissante comportant une face avant munie de motifs choisis réalisés dans un matériau absorbant à la longueur d'onde (λ).

5 Ce masque se caractérise par le fait qu'il comprend des moyens de protection transparents à la longueur d'onde et agencés de manière à maintenir les particules perturbatrices à une distance (H) des motifs supérieure ou égale à l'une des valeurs prises par la profondeur de mise au point (doF) du dispositif lithographique et la hauteur (h) qui est associée au pourcentage toléré d'absorption de photons par les particules perturbatrices.

10 Par exemple, les moyens de protection peuvent être agencés de manière à maintenir les particules perturbatrices à une distance (H) des motifs supérieure ou égale à la plus grande des valeurs prises par la profondeur de mise au point (doF) du dispositif lithographique et la hauteur (h).

15 Cette distance (H) est par exemple comprise entre environ 50 nm et environ 5000 nm. Mais, elle peut être plus grande lorsque l'on utilise une longueur d'onde qui s'éloigne du domaine des rayons X mous.

20 Les moyens de protection du masque peuvent constituer une structure présentant des caractéristiques complémentaires qui peuvent être prises séparément ou en combinaison, et notamment il est préférable que :

- la structure présente une variation maximale d'épaisseur optique choisie de manière à induire localement une déflexion du faisceau négligeable devant la précision de placement des motifs,
- 25 • la structure n'induit pas de variation de phase entre les photons du faisceau réfléchis par le masque,
- la structure soit hydrophobe,
- la structure présente une face avant, opposée aux motifs, pouvant être nettoyée de certaines au moins des particules qu'elle maintient,
- 30 • la structure soit agencée de manière à pouvoir être inspectée, avec un contraste choisi, à l'aide de moyens d'observation travaillant dans le visible ou dans l'ultraviolet (UV),
- la structure soit apte à la thermophorèse,

- la structure soit conductrice de manière à permettre la mise en oeuvre d'un effet électrostatique, par exemple pour repousser les particules perturbatrices,
- la structure soit non diffractante et non diffusante dans l'ultraviolet (UV).

5 Par ailleurs, cette structure peut se présenter sous différentes formes, et notamment :

- elle peut être déposée sur la face avant de la structure réfléchissante et parallèlement à celle-ci, et comprendre au moins une couche antireflet réalisée dans un matériau choisi,
- elle peut se présenter sous la forme d'une mousse d'un matériau choisi,
- 10 • elle peut être réalisée dans un matériau choisi, être déposée sur la face avant de la structure réfléchissante, et définir des canaux permettant de réduire sa densité,
- elle peut comprendre une membrane solidarisée par des piliers à la face avant de la structure réfléchissante, et dans une position sensiblement parallèle à cette face avant, l'épaisseur de la membrane et la hauteur des piliers étant alors choisies de sorte que
15 leur somme soit égale à la distance choisie,
- elle peut être composée de nanotubes, par exemple orientés suivant une direction choisie par rapport à la normale à la face avant de la structure réfléchissante.

Parmi les matériaux qui peuvent être choisis pour réaliser la structure, on peut notamment
20 citer les polymères transparents à la longueur d'onde (λ , par exemple égale à 10,9 nm ou 13,5 nm), le Carbone (C), les nanotubes de Carbone (ou CNT), le Silicium (Si), le Béryllium (Be), le Ruthénium (Ru), l'Argent (Ag) et le Zirconium (Zr).

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'examen de la description
25 détaillée ci-après, et des dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 illustre de façon schématique un exemple de réalisation d'un dispositif de lithographie par réflexion dans l'ultraviolet extrême (EUV),
- la figure 2 illustre de façon schématique, dans une vue en coupe transversale, un premier exemple de réalisation d'un masque à motifs selon l'invention,
- 30 • la figure 3 est un diagramme illustrant l'évolution du paramètre h en fonction du diamètre d des particules perturbatrices, pour deux valeurs d'absorption de photons différentes (1% et 4%),

- la figure 4 illustre de façon schématique, dans une vue en coupe transversale, un deuxième exemple de réalisation d'un masque à motifs selon l'invention,
- la figure 5 illustre de façon schématique, dans une vue en coupe transversale, un troisième exemple de réalisation d'un masque à motifs selon l'invention,
- 5 ◦ la figure 6 illustre de façon schématique, dans une vue en coupe transversale, un quatrième exemple de réalisation d'un masque à motifs selon l'invention, et
- la figure 7 illustre de façon schématique, dans une vue en coupe transversale, un cinquième exemple de réalisation d'un masque à motifs selon l'invention.

10 Les dessins annexés pourront non seulement servir à compléter l'invention, mais aussi contribuer à sa définition, le cas échéant.

L'invention concerne un masque à motifs destiné à être utilisé dans un dispositif de lithographie par réflexion fonctionnant avec une source de photons dont la longueur d'onde
15 (λ) est inférieure à environ 120 nm, c'est-à-dire qui appartient au domaine de l'ultraviolet extrême (EUV) et des rayons X mous, notamment à 10,9 nm et 13,5 nm.

On se réfère tout d'abord à la figure 1 pour décrire un exemple, très schématique, de réalisation d'un dispositif de lithographie par réflexion utilisant un masque à motifs MM selon
20 l'invention.

Un dispositif de lithographie comprend principalement un dispositif optique de formation d'image M3-M8 (également appelé dispositif de projection) et une source S de photons, couplée à des miroirs de collection M1 et M2, implantés dans une enceinte à ultravide E,
25 dans laquelle sont définies, de façon très précise, une zone de positionnement d'un masque à motifs MM et une zone de positionnement d'une tranche (ou "wafer") W.

Le masque à motifs MM est destiné à fonctionner en réflexion. Il sera décrit plus loin en détail.

30

Le wafer W est généralement constitué d'un substrat planaire muni sur l'une de ses faces d'une couche de résine R sensible aux photons délivrés par la source S du dispositif de lithographie.

La source S est par exemple chargée de délivrer des photons dont la longueur d'onde λ est égale à 13,5 nm. Une telle longueur d'onde est par exemple obtenue avec une source à décharge ou à plasma laser, dans du Xénon (Xe) ou de l'Étain (Sn). Mais, bien entendu, elle pourrait délivrer des photons présentant d'autres longueurs d'onde comprises entre environ
5 120 nm et environ 1 nm, et notamment une longueur d'onde égale à 10,9 nm (qui correspond à un autre domaine d'émission du Xénon (Xe)).

Dans l'exemple illustré, les miroirs M1 et M2 et le filtre FR sont chargés de collimater les photons délivrés par la source S, de sorte qu'ils parviennent au niveau de la face avant du
10 masque MM (qui comprend les motifs MF (voir figure 2)) sous la forme d'un faisceau présentant une ouverture numérique NA_i choisie. Par exemple, NA_i est égale à 0,064, ce qui correspond à un angle d'ouverture sur les motifs de $\pm 3,6^\circ$.

Par ailleurs, le dispositif optique de formation d'image M3-M8 (également appelé dispositif
15 optique de projection) est chargé de former l'image des motifs MF du masque MM au niveau de la résine R du wafer W, avec un facteur de réduction choisi, par exemple égal à environ 4. Il est ici constitué de six miroirs M3 à M8, à titre d'exemple.

Les angles d'incidence du faisceau de photons sur les différents miroirs et les positions
20 respectives des différents miroirs sont choisis de manière à permettre l'obtention du facteur de réduction et l'illumination de la couche de résine R sous une ouverture numérique NA_r choisie, par exemple égale à environ 0,25.

L'angle d'incidence α du faisceau de photons par rapport à la normale N à la face avant du
25 masque à motifs MM (voir figure 2) est généralement égal à quelques degrés, par exemple environ 6° .

Bien entendu, il ne s'agit que d'un exemple illustratif très schématisé. De nombreuses autres combinaisons de moyens optiques peuvent être envisagées pour assurer la collimation et la
30 formation d'image.

On se réfère maintenant plus particulièrement à la figure 2 pour décrire un premier exemple de réalisation de masque à motifs MM, selon l'invention. Sur cette figure, comme sur les

figures 4 à 7, les dimensions relatives des différents éléments ne sont pas représentatives de leurs dimensions relatives réelles.

5 Un masque à motifs MM, utilisé en réflexion, comprend tout d'abord un substrat planaire ST dont l'une des faces est solidarisée à une structure SMR réfléchissante à la longueur d'onde λ des photons de la source S et comportant une face avant munie de motifs MF choisis, réalisés dans un matériau absorbant à la longueur d'onde λ .

10 Par exemple, la structure réfléchissante SMR est une structure multicouches constituée d'un empilement de 40 paires de couches de Silicium (Si), par exemple de 4 nm d'épaisseur, et de Molybdène (Mo), par exemple de 2,7 nm d'épaisseur.

Des couches tampon et de protection peuvent être ajoutées pour des raisons technologiques.

15 Les motifs absorbants sont par exemple réalisés en Chrome (Cr) ou en TaN. Mais, tout autre matériau absorbant à la longueur d'onde λ des photons (ici égale à 13,5 nm) peut être envisagé. L'épaisseur des motifs MF est préférentiellement réduite de manière à éviter les effets de bord des masques dont les dimensions sont typiquement de l'ordre de 152 mm x 152 mm (pour une zone de 104 mm x 104 mm réservée aux motifs MF). Par ailleurs, compte tenu
20 d'un facteur de réduction d'environ 4, les traits imprimés dans la couche de résine R ont par exemple une largeur de 25 nm, 32 nm ou 45 nm, ce qui correspond à des motifs MF dont les largeurs sont respectivement de 100 nm, 128 nm et 180 nm.

25 Comme le sait l'homme de l'art, et comme évoqué dans la partie introductive, de nombreuses particules perturbatrices PP de très petites dimensions (par exemple 30 à 60 nm) sont susceptibles de venir s'insérer entre les parties absorbantes constituant les motifs MF, altérant ainsi l'intégrité du masque MM. Les particules perturbatrices PP ne gênent de façon sensible ni la formation d'image ni l'absorption, lorsqu'elles sont placées sur les parties absorbantes.

30 Afin d'empêcher qu'une telle insertion ne survienne, l'invention propose de placer devant les motifs MF des moyens de protection SP transparents à la longueur d'onde λ des photons et chargés de maintenir les particules perturbatrices PP à une distance H des motifs, qui est supérieure ou égale à l'une des valeurs prises par la profondeur de mise au point doF du

dispositif lithographique et la hauteur h associée au pourcentage toléré d'absorption de photons par les particules perturbatrices PP.

La profondeur de mise au point doF est égale à λ / NA_i^2 . Par exemple dans le cas d'une
 5 ouverture numérique NA_i égale à 0,064 et d'une longueur d'onde λ égale à 13,5 nm on obtient une profondeur de mise au point doF égale à environ 3296 nm. Bien entendu, il ne s'agit que d'un exemple, et doF peut varier typiquement entre environ 50 nm et environ 5000 nm en fonction des valeurs choisies pour NA_i et λ , voire même plus encore lorsque l'on utilise une longueur d'onde qui s'éloigne du domaine des rayons X mous.

10

Par ailleurs, il est rappelé que le pourcentage d'absorption de photons par les particules perturbatrices PP est défini par le facteur (ou pourcentage) d'ombre qui est donné par la formule :

$$\text{Pourcentage d'Ombre} = \left(\frac{d}{h * 2NA_i} \right)^2$$

15 où d est le diamètre des particules perturbatrices PP, h est le paramètre représentatif de la hauteur séparant les particules perturbatrices des motifs MF.

Si l'on tolère une absorption de photons égale à environ 1%, on obtient alors la relation simplifiée $h = 80 * d$. En revanche, si l'on tolère une absorption de photons égale à environ
 20 4%, on obtient alors la relation simplifiée $h = 40 * d$. On a représenté sur le diagramme de la figure 3 l'évolution du paramètre h (en nanomètres (nm)) en fonction du diamètre d (en nanomètres (nm)) des particules perturbatrices, pour des valeurs d'absorption de photons égales à 1% (courbe supérieure) et à 4% (courbe inférieure).

25 Plus le diamètre d de la particule perturbatrice PP est petit, moins le paramètre h intervient dans le choix de la distance H séparant la partie avant du moyen de protection SP de la face avant de la structure réfléchissante SMR (où sont formés les motifs MF). La valeur de H doit donc être choisie supérieure ou égale à l'une des valeurs prises par doF et h .

30 Par exemple, au premier ordre on peut fixer les conditions suivantes : si doF est supérieure à h , la distance H doit être supérieure ou égale à doF , tandis que si doF est inférieure à h , la

distance H doit être supérieure ou égale à h. En d'autres termes, au premier ordre, la valeur de H est choisie supérieure ou égale à la plus grande des valeurs prises par doF et h. Des calculs de simulation de formation d'image prenant en compte des paramètres complémentaires, comme par exemple la diffraction et/ou les différences d'indice, permettent d'affiner les conditions précitées.

Les moyens de protection SP peuvent par ailleurs présenter une ou plusieurs caractéristiques complémentaires qui peuvent en renforcer les performances et/ou les avantages.

Il est par exemple avantageux que les moyens de protection SP n'absorbent pas (ou très peu) les photons. Il est en effet rappelé qu'en lithographie par réflexion l'épaisseur optique T des moyens de protection SP est traversée deux fois. A cet effet, il est préférable d'utiliser un matériau à faible, voire très faible, vieillissement, résistant au faisceau de photons et à faible, voire très faible, oxydation.

On remarquera qu'une particule perturbatrice PP peut être traversée deux fois, mais pas par le même faisceau.

Il est par exemple également avantageux que les moyens de protection SP présentent une variation maximale d'épaisseur optique T induisant localement une déflexion du faisceau de photons négligeable devant la précision de placement des motifs MF.

Il est par exemple également avantageux que les moyens de protection SP n'induisent pas (ou très peu) de variation de phase entre les photons du faisceau qui sont réfléchis par le masque MM.

Il est par exemple également avantageux que les moyens de protection SP soient hydrophobes. Il en est rappelé que les molécules d'eau (H_2O) sont absorbantes à 13,5 nm.

Il est par exemple également avantageux que la face avant des moyens de protection SP, qui est opposée aux motifs MF, puisse être nettoyée de certaines au moins des particules perturbatrices PP qu'elle maintient. Dans ce cas, il est préférable que les moyens de

protection SP puissent être inspectés, avec un contraste choisi, à l'aide de moyens d'observation travaillant dans le visible ou dans l'ultraviolet, par exemple à 248 nm.

5 Au lieu de nettoyer la face avant des moyens de protection SP, on peut envisager de les retirer du masque MM afin de les remplacer. Ce retrait peut par exemple s'effectuer par combustion ou par oxydation (notamment lorsqu'ils sont réalisés à base de nanotubes de carbone, comme on le verra plus loin) à l'aide de gaz carbonique (CO_2), lequel est ensuite évaporé et pompé afin d'éviter les dépôts résiduels. Une fois ce retrait effectué, on peut alors inspecter le masque MM puis déposer de nouveaux moyens de protection SP sur sa face
10 avant.

Il est par exemple également avantageux que les moyens de protection SP soient aptes à la thermophorèse.

15 Il est par exemple également avantageux que les moyens de protection SP soient conducteurs électriquement, afin de les utiliser pour mettre en oeuvre un effet électrostatique, par exemple pour repousser les particules perturbatrices lorsqu'elles sont ionisées.

Il est par exemple également avantageux que les moyens de protection SP soient non
20 diffractants et non diffusants dans l'ultraviolet (UV), y compris dans l'UV extrême, pour la qualité de l'image, notamment lorsque la longueur d'onde est égale à 13,5 nm, et pour la qualité et le contraste lors de l'inspection.

De nombreuses structures peuvent constituer les moyens de protection SP présentés ci-avant.
25 Ces structures doivent toujours être solidarisées au substrat ST ou à la structure réfléchissante SMR, et peuvent comprendre une partie assurant le maintien à distance des particules perturbatrices PP, également appelée pellicule (ou membrane), qui est soit distante des motifs MF, soit au contact de ceux-ci.

30 Comme cela est schématiquement illustré sur la figure 1, les moyens de protection SP peuvent constituer une structure antireflet plane, de préférence de type multicouches, déposée sur la face avant de la structure réfléchissante SMR et parallèlement à celle-ci. A cet effet, on peut par exemple utiliser des couches en Mo-Si.

Dans une première variante, illustrée sur la figure 4, les moyens de protection SP peuvent constituer une structure composée de nanotubes orientés suivant une direction choisie par rapport à la normale N à la face avant de la structure réfléchissante SMR. Par exemple, on peut utiliser des nanotubes en carbone ou (CNT), présentant préférentiellement des parois d'épaisseur monoatomique, espacés les uns des autres d'une distance inférieure au diamètre des particules perturbatrices PP les plus petites, et pouvant éventuellement présenter une désorientation par rapport à la normale N.

Dans une deuxième variante, illustrée sur la figure 5, les moyens de protection SP peuvent constituer une structure comportant des couches CL dans lesquelles sont définis des canaux CX de dimensions adaptées par rapport à celles des particules perturbatrices PP, en vue de les bloquer au niveau de leurs extrémités avant. Ces canaux CX étant remplis de "vide", ils permettent de réduire la densité du matériau. Une telle structure peut être définie à l'aide d'une technique de lithographie appliquée à un matériau tel que le Silicium (Si) ou un polymère, comme par exemple le PMMA. Elle peut également être obtenue par ajout sur la face avant de la structure réfléchissante SMR d'un cristal photonique ou de Silicium poreux.

Dans une troisième variante, illustrée sur la figure 6, les moyens de protection SP peuvent constituer une structure en mousse formant une membrane (ou pellicule), préférentiellement solidarisée à la face avant de la structure réfléchissante SMR. Comme dans la deuxième variante, la mousse contient de nombreux espaces vides qui permettent de réduire la densité du matériau. Cette mousse peut être par exemple réalisée à partir d'un polymère, tel que le PMMA, ou de nanotubes, par exemple en carbone (ou CNT), ou de Béryllium (Be), ou de Ruthénium (Ru), ou d'Argent (Ag), ou encore de Zirconium (Zr).

Dans une quatrième variante, illustrée sur la figure 7, les moyens de protection SP peuvent constituer une structure constituée d'une membrane (ou pellicule) ME solidarisée par des piliers PS à la face avant de la structure réfléchissante SMR. Certaines extrémités de piliers PS peuvent s'appuyer sur les motifs MF, comme illustré. La membrane ME est placée sensiblement parallèlement à la face avant de la structure réfléchissante SMR. Par ailleurs, l'épaisseur de la membrane ME et la hauteur des piliers PS sont choisies de sorte que leur somme soit égale à la distance H choisie. Les piliers peuvent être par exemple obtenus par croissance de germes (ou "seeds"). Une telle structure peut être par exemple réalisée à partir

d'un polymère, tel que le PMMA, ou de Silicium (Si), ou encore dans un matériau antireflet, tel que Mo-Si. Le matériau constituant cette structure peut également se présenter sous la forme d'une mousse, comme dans la troisième variante présentée ci-avant en référence à la figure 6.

5

L'invention ne se limite pas aux modes de réalisation de masque à motifs décrits ci-avant, seulement à titre d'exemple, mais elle englobe toutes les variantes que pourra envisager l'homme de l'art dans le cadre des revendications ci-après.

REVENDICATIONS

1. Masque (MM) à motifs (MF), pour un dispositif de lithographie par réflexion d'un faisceau de photons de longueur d'onde inférieure à environ 120 nm, comprenant un substrat planaire (ST) solidarisé à une structure réfléchissante (SMR) comportant une face avant munie de motifs (MF) choisis, réalisés dans un matériau absorbant à ladite longueur d'onde, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de protection (SP) transparents à ladite longueur d'onde et agencés pour maintenir des particules perturbatrices (PP) à une distance (H) desdits motifs (MF) supérieure ou égale à l'une de deux valeurs prises parmi une profondeur de mise au point (doF) dudit dispositif et une hauteur motif/particule perturbatrice (h) associée à un pourcentage toléré d'absorption de photons par lesdites particules perturbatrices (PP), fonction de leur diamètre (d).
2. Masque selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (SP) sont agencés pour maintenir les particules perturbatrices (PP) à une distance (H) desdits motifs (MF) supérieure ou égale à la plus grande des deux valeurs prises par la profondeur de mise au point (doF) du dispositif et la hauteur motif/particule perturbatrice (h).
3. Masque selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (SP) constituent une structure présentant une variation maximale d'épaisseur optique choisie de manière à induire localement une déflexion du faisceau négligeable devant la précision de placement desdits motifs (MF).
4. Masque selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (SP) constituent une structure n'induisant sensiblement pas de variation de phase entre photons du faisceau réfléchis par ledit masque.
5. Masque selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (SP) constituent une structure hydrophobe.

6. Masque selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (SP) constituent une structure dont au moins une face avant, opposée auxdits motifs(MF), est propre à être nettoyée de certaines au moins des particules perturbatrices (PP) qu'elle maintient.
- 5
7. Masque selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (SP) constituent une structure propre à être inspectée, avec un contraste choisi, à l'aide de moyens d'observation travaillant dans le visible ou dans l'ultraviolet.
- 10
8. Masque selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (SP) constituent une structure apte à la thermophorèse.
- 15
9. Masque selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (SP) constituent une structure conductrice apte à mettre en oeuvre un effet électrostatique.
- 20
10. Masque selon la revendication 9, caractérisé en ce que ledit effet électrostatique est destiné à repousser lesdites particules perturbatrices (PP).
- 25
11. Masque selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (SP) constituent une structure non diffractante et non diffusante dans l'ultraviolet.
- 30
12. Masque selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que ladite distance (H) est comprise entre environ 50 nm et environ 5000 nm.
13. Masque selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (SP) constituent une structure déposée sur la face avant de la structure réfléchissante et parallèlement à celle-ci, et comprenant au moins une couche antireflet réalisée dans un matériau choisi.

14. Masque selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (SP) constituent une structure constituée d'une mousse d'un matériau choisi.
- 5 15. Masque selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (SP) constituent une structure réalisée dans un matériau choisi, déposée sur la face avant de la structure réfléchissante (SMR), et définissant des canaux (CX) permettant de réduire la densité dudit matériau.
- 10 16. Masque selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (SP) constituent une structure comprenant une membrane (ME) solidarisée par des piliers (PS) à la face avant de la structure réfléchissante, et dans une position sensiblement parallèle à ladite face avant, l'épaisseur de ladite membrane (ME) et la hauteur desdits piliers (PS) étant choisies de sorte que leur somme soit
15 égale à ladite distance choisie (H).
17. Masque selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que lesdits moyens de protection (PS) constituent une structure composée de nanotubes orientés suivant une direction choisie par rapport à la normale (N) à ladite face avant de la structure
20 réfléchissante (SMR).
18. Masque selon l'une des revendications 13 à 17, caractérisé en ce que ledit matériau est choisi parmi au moins les polymères transparents à ladite longueur d'onde, le Carbone, les nanotubes de Carbone, le Silicium, le Béryllium, le Ruthénium, l'Argent
25 et le Zirconium.

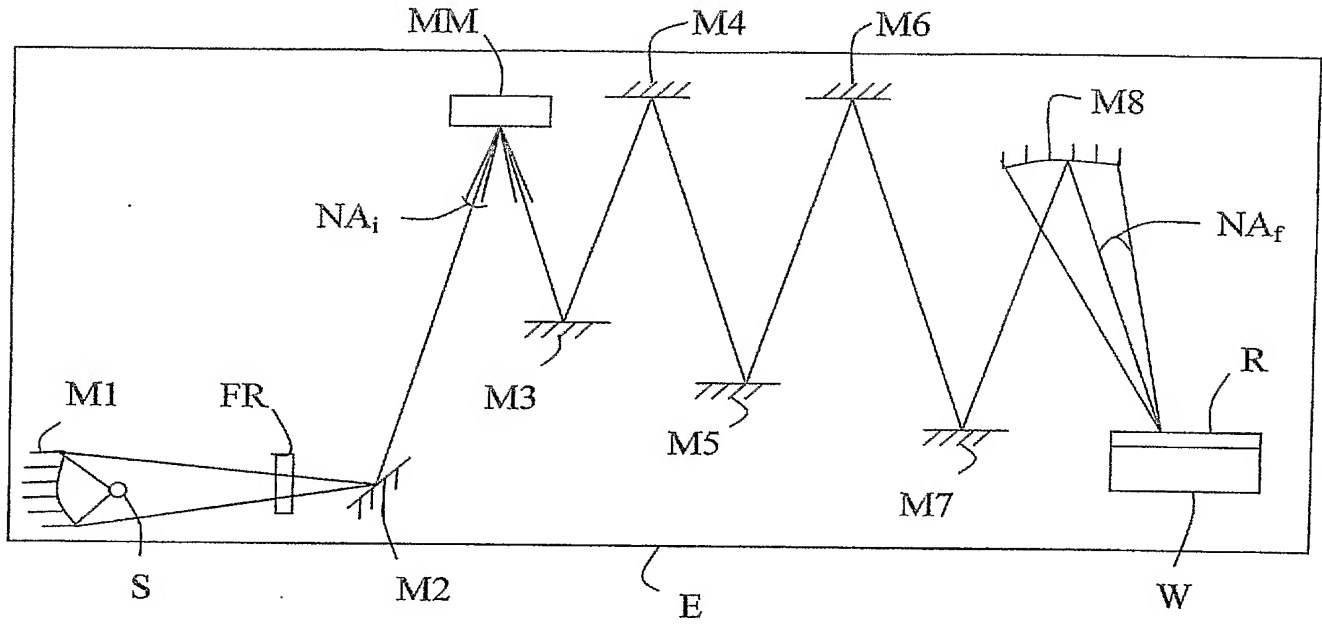


FIG.1

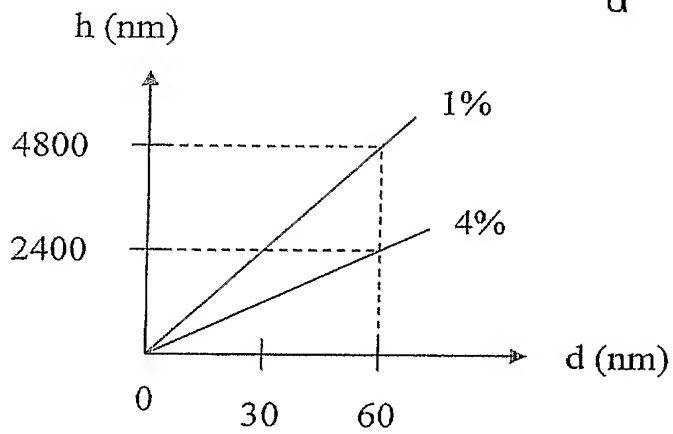
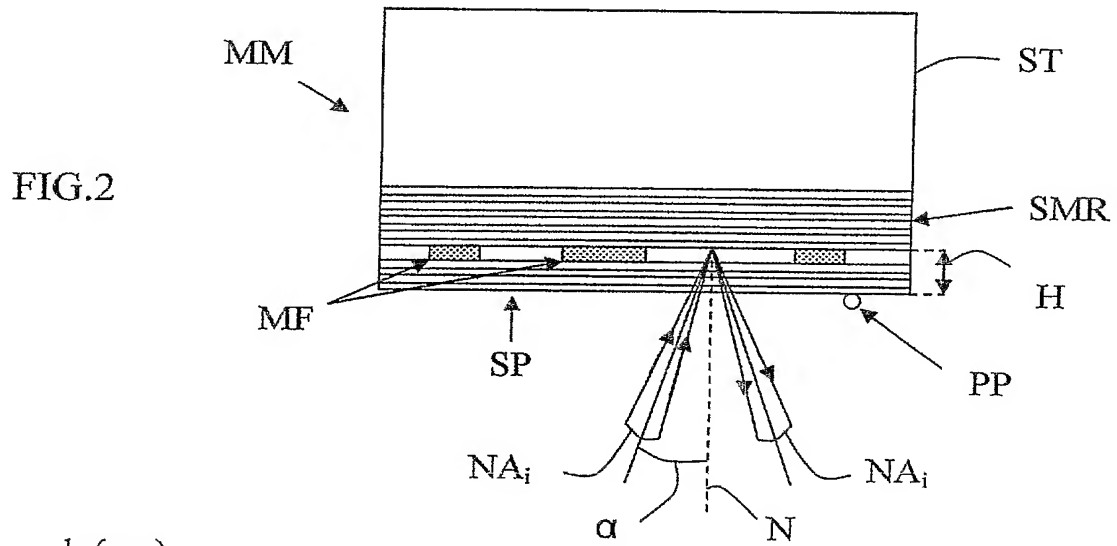


FIG.3

FIG.4

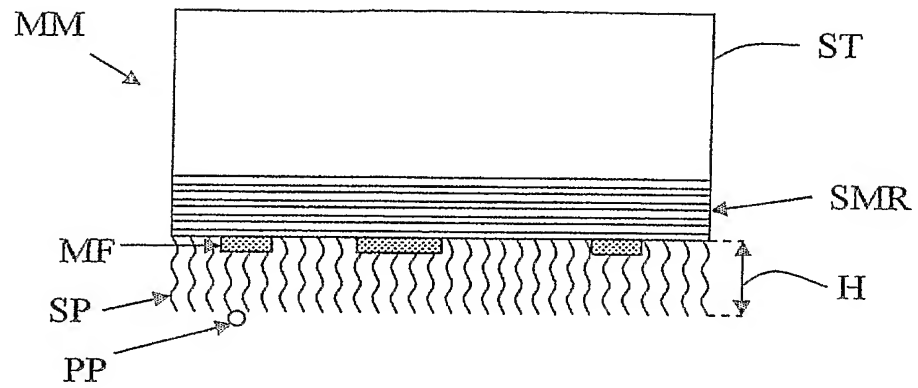


FIG.5

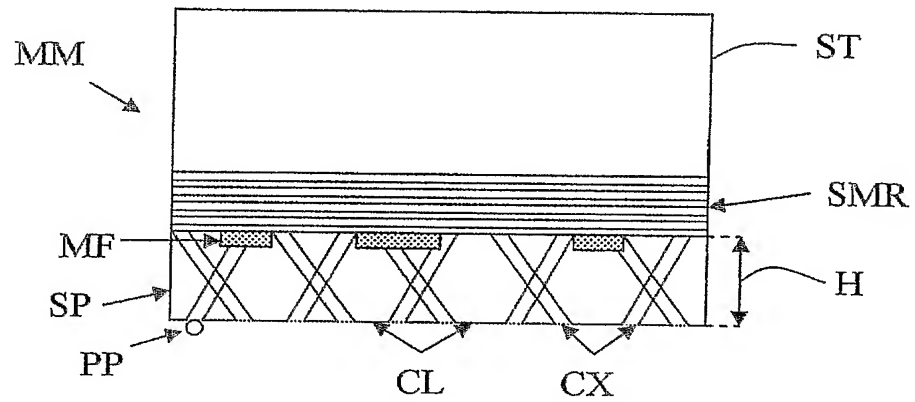


FIG.6

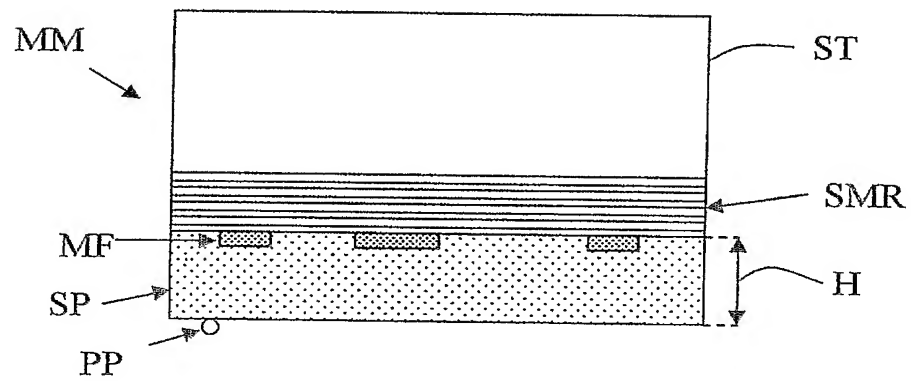
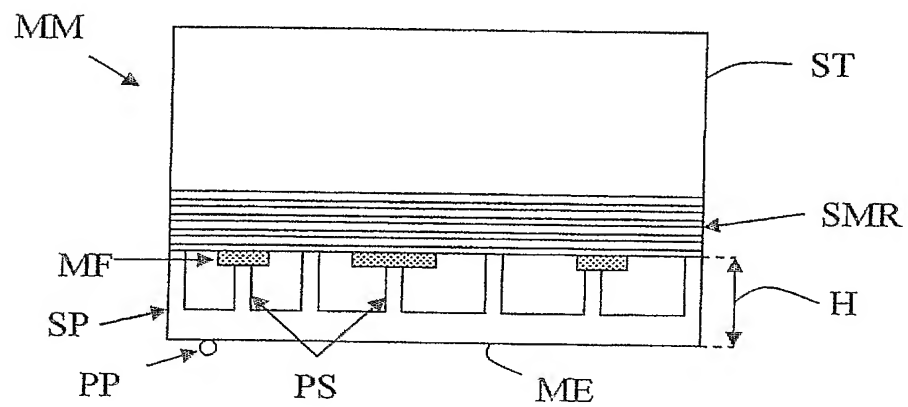


FIG.7





BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*02

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		SOPRA 20 (121001)	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0400907	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Masque à motifs protégés, pour la lithographie par réflexion dans le domaine de l'extrême UV et des rayons X mous			
LE(S) DEMANDEUR(S) : SOCIETE DE PRODUCTION ET DE RECHERCHES APPLIQUEES - SOPRA			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		STEHLE	
Prénoms		Jean-Louis	
Adresse	Rue	19 rue des Arts	
	Code postal et ville	92700	COLOMBES
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Paris, le 30 janvier 2004 Jean-Yves PLAÇAIS 92-117 (B)(M)			



7 9 4

5

